

структурой она неприменима, т. к. их спектр колебаний сложен.

В кристаллах «слоистого» или «цепочечного» типа (квазиодномерные соединения и квазидвумерные соединения) спектр звуковых колебаний характеризуется не одной, а неск.  $\theta_d$ , различными по порядку величины. Закон  $T^3$  для Р. т. имеет при этом место лишь при  $T$ , малых по сравнению с наименьшей из дебаевских темп-р., в промежуточных же областях  $T$  возникают др. законы. Если обозначить через  $\eta$  отношение энергии связи между слоями и энергии связи между атомами в слоях, то закон  $T^3$  для Р. т. будет иметь место лишь при  $T \ll \eta^2 \theta_d^m$ , где  $\theta_d^m$  — наибольшая из  $\theta_d$ . В области  $\eta^2 \theta_d^m \ll T \ll \eta \theta_d^m$  имеют место зависимости:  $C \propto T^2$  для слоистых и  $C \propto T^{1/2}$  для цепочечных кристаллов. При  $\eta \theta_d^m \ll T \ll \theta_d^m$  имеют место зависимости  $C \propto T$  и  $C \propto T^{1/2}$ .

**Влияние дефектов.** Величина и температурная зависимость Р. т. кристаллов зависят от наличия дефектов и примесей. К увеличению низкотемпературной Р. т. при  $T \sim \omega_p \hbar/k$  могут привести резонансные квазиколебания с частотами  $\omega_p \ll \omega_d$ , к-рые возникают благодаря введению тяжелых примесей или дефектов. Локальные ВЧ-колебания ( $\omega_p > \omega_d$ ) слабо влияют на Р. т. Заметный вклад в низкотемпературную Р. т. могут давать также т. н. ориентационые дефекты (дипольные центры) и нецентральные ионы.

**Решеточная теплоёмкость некристаллических веществ** (аморфных или стеклообразных твёрдых тел, полимеров, ионных суперпроводников) при низких  $T$  кардинально отличается от Р. т. кристаллов. При  $T < 1$  К Р. т. этих веществ существенно превышает Р. т. кристаллов и зависит от  $T$  приблизительно линейно. При  $T \sim 10$  К в зависимости  $C(T)$  появляется максимум, свидетельствующий об избыточной (по сравнению с дебаевской) теплоёмкости (рис. 2). Такое поведение и ве-

экспоненциально зависит от параметров барьера в двухъярусном потенциале. Рааброс значений этих параметров в некристаллич. веществе приводит к появлению экспоненциально широкого спектра времен релаксации. В результате возникает логарифмически слабая зависимость измеряемой Р. т. от времени эксперимента.

Лит.: Ландаль Л. Д., Лифшиц Е. М., Статистическая физика, ч. 1, 3 изд., М., 1976; Киттель Ч., Введение в физику твёрдого тела, пер. с англ., М., 1978; Amorphous solids. Low-temperature properties, ed. by W. A. Phillips, B.—[a. o.], 1981.

В. Г. Карпов.

**РИГИ — ЛЕДЮКА ЭФФЕКТ** — заключается во влиянии магн. поля на теплопроводность электронных полупроводников. Открыт практически одновременно в 1887 А. Риги (A. Righi) и С. Ледюком (S. Leduc). Обусловлен, как все гальваномагнитные явления и термогальваномагнитные явления, искривлением траектории носителей заряда в магн. поле. Для наблюдения Р.—Л. э. используют след. геометрию: проводник, в к-ром вдоль оси  $x$  есть градиент темп-ры  $\partial T / \partial x$  и поток тепла  $W = (W, 0, 0)$ , помещают в магн. поле  $H = (0, 0, H)$ , перпендикулярное  $W$ ; вдоль оси  $y$  (перпендикулярно  $W$  и  $H$ ) появляется градиент темп-ры

$$\frac{\partial T}{\partial y} = A_{RL} H \frac{\partial T}{\partial x}.$$

Коэф. Риги — Ледюка  $A_{RL}$  даётся ф-лой (по порядку величин)

$$A_{RL} = e\tau/mc.$$

Здесь  $\tau$  — время свободного пробега носителей заряда (время релаксации импульса),  $m$  — их эф. масса. Для электронов  $A_{RL} < 0$ , для дырок  $A_{RL} > 0$ . Существует приближённое соотношение между  $A_{RL}$ , константой Холла  $R$  (см. Холла эффект) и уд. проводимостью  $\sigma$ :

$$A_{RL} = \sigma R.$$

Лит. см. при ст. Термогальваномагнитные явления.

**РИДБЕРГ (Ry)** — внесистемная единица энергии, применяемая в атомной физике и оптике. Названа в честь И. Р. Ридберга (J. R. Rydberg). 1 Р. = 13,60 эВ, т. е. энергии связи электрона в атоме водорода в основном состоянии (см. Атом). 1 Р. =  $2,1796 \cdot 10^{-11}$  эрг =  $=1/2$  единицы энергии в Хартри системе единиц.

**РИДБЕРГА ПОСТОЯННАЯ,  $R$**  — фундаментальная физическая константа, входящая в выражения для расчёта уровней энергии и частот излучения атома. Введена И. Р. Ридбергом (J. R. Rydberg) в 1890. Если принять, что масса атомного ядра бесконечно велика по сравнению с массой электрона (ядро неподвижно), то, согласно квантовомеханич. расчёту,  $R_\infty = 2\pi^2 me^4/c\hbar^3 = 10973731,534(13) \text{ м}^{-1}$  (на 1986), где  $e$  и  $m$  — заряд и масса электрона,  $R_\infty hc = 13,6056981(40) \text{ эВ}$ . При учёте движения ядра масса электрона заменяется на приведенную массу электрона и ядра; в этом случае  $R_i = R_\infty/(1 + m/M_i)$ , где  $M_i$  — масса ядра.

**РИДБЕРГОВСКИЕ СОСТОЯНИЯ** — состояния атомов, ионов и молекул с большими значениями главного квантового числа  $n$  (высоковоизбуждённые состояния). Названы в честь И. Р. Ридберга (J. R. Rydberg),первые экспериментально исследовавшего атомные спектры вблизи границы ионизации [1].

Р. с. атомов и ионов характеризуются чрезвычайно малыми (по атомным масштабам) ионизацией, потенциалами, большими временами жизни (т. к. вероятность излучения квантовых переходов с них мала) и большими радиусами орбит высоковоизбуждённого (ридберговского) электрона. Р. с. подобны состояниям атома водорода. Переходы между соседними Р. с. лежат в радиодиапазоне. Большое значение  $n$  позволяет применять для описания Р. с. квазиклассич. приближение и использовать для них понятия классич. механики. Большие размеры орбит и малые энергии связи ридберговского электрона обусловливают высокую чувствительность Р. с. к воздействию электрич. и магн. полей и большие

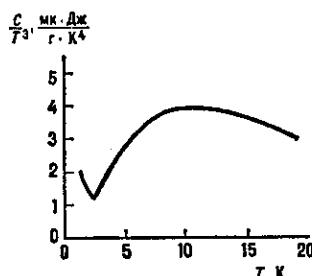


Рис. 2. Зависимость  $C(T)$  аморфного кварца ( $a = \text{SiO}_2$ ). Рост в зависимости  $C(T)$  дальше минимума обусловлен линейной зависимостью теплоёмкости от  $T$ .

личина Р. т. слабо зависит от хим. состава и типа проводимости некристаллич. веществ, являясь в этом смысле универсальными. Так, зависимость  $C \propto T$  наблюдается не только в диэлектрических и полупроводниковых стеклах, но и в металлических стеклах. В последнем случае она экспериментально отделяется от электронной теплоёмкости по наблюдению и сверхпроводящем состоянию, когда электронная теплоёмкость пренебрежимо мала.

Линейная зависимость от темп-ры  $C \propto T$  объясняется моделью двухуровневых систем, отвечающих туннельным состояниям атомов в двухъярусных потенциалах, существование к-рых связано с неупорядоченностью системы (см. Неупорядоченные системы). Постулируется равномерное распределение энергий с плотностью  $g(\epsilon) = \text{const}$ . Это приводит к соотношению

$$C = \int_0^{\epsilon_{\max}} d\epsilon g(\epsilon) V \left( \frac{\epsilon}{2kT} \right)^2 \left( \sinh \frac{\epsilon}{2kT} \right)^{-2} \simeq \frac{\pi}{6} k g V T. \quad (6)$$

Предполагается, что верхняя граница спектра  $\epsilon_{\max} \gg kT$ . Тепловое возбуждение двухуровневых систем происходит за время релаксации, величина к-рого